

(19)



JAPANESE PATENT OFFICE

PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **10062258 A**

(43) Date of publication of application: **06.03.98**

(51) Int. Cl

G01J 9/02

G01B 9/02

G01M 11/00

(21) Application number: **08218688**

(71) Applicant: **TOSHIBA CORP**

(22) Date of filing: **20.08.96**

(72) Inventor: **FUJIWARA TAKESHI
OHASHI KATSUKI
ONO AKIRA**

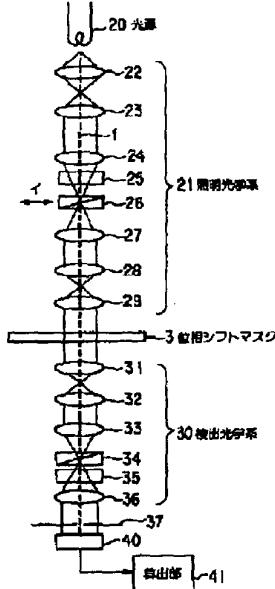
(54) PHASE SHIFT MASK INSPECTION APPARATUS

(57) Abstract:

PROBLEM TO BE SOLVED: To highly accurately measure a phase amount of a phase shifter to improve reliability.

SOLUTION: Lamp light or excimer laser light emitted from a light source 20 with center wavelength of 300nm or less and having the same wavelength as that of an exposure device is split into two linear polarized light beams orthogonal to each other by an illumination optic system 21 including an illumination side Wollaston prism 26 to be shed to a phase shift mask 3. The two linear polarized light beams which have transmitted through the phase shift mask 3 are overlaid by a detection optic system 30, and based on interference light, a calculation part 41 obtains a phase amount of a phase shifter 2 of the phase shift mask 3.

COPYRIGHT: (C)1998,JPO



(19) 日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

(11) 特許出願公開番号

特開平10-62258

(43) 公開日 平成10年(1998)3月6日

(51) Int.Cl.⁶
G 0 1 J 9/02
G 0 1 B 9/02
G 0 1 M 11/00

識別記号 庁内整理番号

F I
G 0 1 J 9/02
G 0 1 B 9/02
G 0 1 M 11/00

技術表示箇所

T

審査請求 未請求 請求項の数5 O.L (全6頁)

(21) 出願番号 特願平8-218688

(22) 出願日 平成8年(1996)8月20日

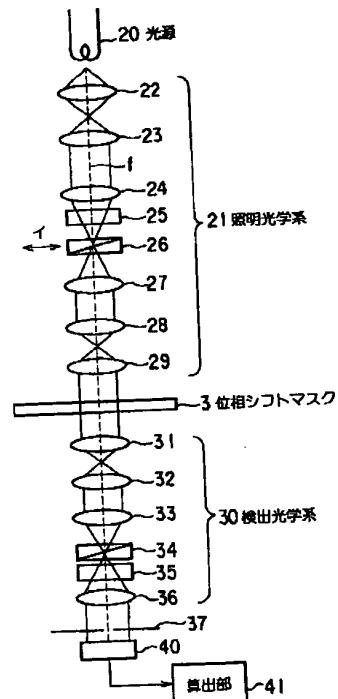
(71) 出願人 000003078
株式会社東芝
神奈川県川崎市幸区堀川町72番地
(72) 発明者 藤原 剛
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株
式会社東芝生産技術研究所内
(72) 発明者 大橋 勝樹
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株
式会社東芝生産技術研究所内
(72) 発明者 小野 明
神奈川県横浜市磯子区新磯子町33番地 株
式会社東芝生産技術研究所内
(74) 代理人 弁理士 鈴江 武彦 (外6名)

(54) 【発明の名称】 位相シフトマスク検査装置

(57) 【要約】

【課題】 本発明は、位相シフタの位相量を高精度に測定して信頼性を向上する。

【解決手段】 光源20から放射された中心波長300nm以下で露光装置と同一の波長のランプ光又はエキシマレーザ光を、照明側ウォラストンプリズム26を備えた照明光学系21により互いに直交する2つの直線偏光に分離して位相シフトマスク3に照射し、この位相シフトマスク3を透過した2つの直線偏光を検出光学系30により重ね合わせ、その干渉光に基づいて算出部41により位相シフトマスク3の位相シフタ2の位相量を求める。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 遠紫外光を放射する光源と、この光源から放射された遠紫外光を互いに直交する偏光面を持つ2つの直線偏光に分離して位相シフトマスクに照射する照明光学系と、前記位相シフトマスクを透過した2つの直線偏光を重ね合わせて干渉光を発生させる検出光学系と、この検出光学系により検出された干渉光の強度に基づいて前記位相シフトマスクにおける位相シフタの位相量を求める位相量算出手段と、を具備したことを特徴とする位相シフトマスク検査装置。

【請求項2】 遠紫外光を拡散放射するランプと、遠紫外のレーザ光を出力するレーザ光源と、前記レーザ光源からのレーザ光を等価な強度を持つ拡散放射の光源に変換する光源変換光学系と、前記ランプから拡散放射された遠紫外光又は前記光源変換光学系により変換された拡散放射のレーザ光を互いに直交する偏光面を持つ2つの直線偏光に分離して位相シフトマスクに照射する照明光学系と、前記位相シフトマスクを透過した2つの直線偏光を重ね合わせて干渉光を発生させる検出光学系と、この検出光学系により検出された干渉光の強度に基づいて前記位相シフトマスクにおける位相シフタの位相量を求める位相量算出手段と、を具備したことを特徴とする位相シフトマスク検査装置。

【請求項3】 前記照明光学系は、ウォラストンプリズムを用いたことを特徴とする請求項1又は2記載の位相シフトマスク検査装置。

【請求項4】 中心波長が3000nm以下の遠紫外光又はレーザ光を位相シフトマスクに照射することを特徴とする請求項1又は2記載の位相シフトマスク検査装置。

【請求項5】 前記ランプとして水銀ランプを用い、前記レーザ光源としてエキシマレーザ装置を用いたことを特徴とする請求項2記載の位相シフトマスク検査装置。

【発明の詳細な説明】

【0001】

【発明の属する技術分野】 本発明は、半導体素子を製造するときのリソグラフィー工程において被投影原版として用いられる遠紫外光用フォトマスク（レチクル）の検査に係わり、特に位相シフトマスクの位相シフタの位相量を測定する位相シフトマスク検査装置に関する。

【0002】

【従来の技術】 半導体素子を製造するときのリソグラフィー工程では、例えば半導体露光装置において位相シフトマスクを用いた露光が行われている。この位相シフトマスクを用いた露光は、例えば図3に示すようにガラス基板1上に光の位相を180°反転させる位相シフト膜

（位相シフター）2を形成した位相シフトマスク3を用いて露光するもので、パターンの境界部で光強度が零となり、レジストの解像度を大幅に向上でき、焦点深度も大きく向上する。

【0003】 このような位相シフトマスク3は、位相シフタ2として半透明の膜（ハーフトーン型）を用いており、この位相シフタ2での位相量が露光波長の2分の1であることが必要であり、このために位相シフタ2の位相量測定が行われている。

【0004】 図4はかかる位相シフタの位相量測定装置の構成図である。水銀アークランプ4から放射される光の光路上には、i、h、g及びe線のフィルタ5、グレーティングアーチャ6、コンデンサレンズ7が配置され、これらフィルタ5、グレーティングアーチャ6、コンデンサレンズ7を通った光が位相シフトマスク3のガラス基板1及び位相シフタ2に照射される。

【0005】 この位相シフトマスク3のガラス基板1及び位相シフタ2を透過した各光は、対物レンズ8を通して第1の偏光プリズム9に入射し、この第1の偏光プリズム9により2つの光路に分岐される。

【0006】 これら2つの光路上には、可変シアリング楔10、可変位相シフタ11がそれぞれ配置され、これら可変シアリング楔10、可変位相シフタ11を透過した各光は、第2の偏光プリズム12により重ね合わされる。

【0007】 そして、第2の偏光プリズム12により重ね合わされた光は、ピンホールミラー13のピンホール13aを通して光増倍管14に入射すると共にピンホールミラー13で反射しレンズ15を通してイメージディテクタ16に入射する。

【0008】 従って、イメージディテクタ16に入射する光は、位相シフトマスク3のガラス基板1と位相シフタ2とを透過した各光の干渉縞となることから、イメージディテクタ16の出力信号に基づいて位相シフタ2の位相量を求める。

【0009】

【発明が解決しようとする課題】 しかしながら、上記装置では、第1の偏光プリズム9により2つの光路に分岐し、これら2つの光をそれぞれ可変シアリング楔10、可変位相シフタ11に透過させているので、別々の光路を通過することから例えばこれら2つの光路における空気の流れの状態がそれぞれ異なることが生じ、例えば一方の光路の空気の流れが乱れると、その影響が位相シフタ2の位相量測定結果に現れてしまい、測定結果の信頼性を低下させてしまう。

【0010】 又、上記位相シフトマスクを使用する半導体露光装置には、光源としてランプ光源とレーザ光源とを有するものがある。しかし、従来の位相シフトマスク検査装置では、光源の種類毎に検査可能なものと不可能なものがある。

【0011】そこで本発明は、位相シフタの位相量を高精度に測定できる信頼性を向上させた位相シフトマスク検査装置を提供することを目的とする。又、本発明は、ランプ光源とレーザ光源とを切り替えることで半導体露光装置の光源がランプ光源であってもレーザ光源であっても1台の装置で検査することができる位相シフトマスク検査装置を提供することを目的とする。

【0012】

【課題を解決するための手段】請求項1によれば、遠紫外外光を放射する光源と、この光源から放射された遠紫外外光を互いに直交する偏光面を持つ2つの直線偏光に分離して位相シフトマスクに照射する照明光学系と、位相シフトマスクを透過した2つの直線偏光を重ね合わせて干渉光を発生させる検出光学系と、この検出光学系により検出された干渉光の強度に基づいて位相シフトマスクにおける位相シフタの位相量を求める位相量算出手段と、を備えた位相シフトマスク検査装置である。

【0013】このような位相シフトマスク検査装置であれば、光源から放射された遠紫外外光は、照明光学系により互いに直交する偏光面を持つ2つの直線偏光に分離されて位相シフトマスクに照射される。

【0014】この位相シフトマスクを透過した2つの直線偏光は、検出光学系により重ね合わせられ、その干渉光に基づいて位相量算出手段により位相シフトマスクの位相シフタの位相量が求められる。

【0015】請求項2によれば、遠紫外外光を拡散放射するランプと、遠紫外のレーザ光を出力するレーザ光源と、レーザ光源からのレーザ光を等価な強度を持つ拡散放射の光源に変換する光源変換光学系と、ランプから拡散放射された遠紫外光又は光源変換光学系により変換された拡散放射のレーザ光を互いに直交する偏光面を持つ2つの直線偏光に分離して位相シフトマスクに照射する照明光学系と、位相シフトマスクを透過した2つの直線偏光を重ね合わせて干渉光を発生させる検出光学系と、この検出光学系により検出された干渉光の強度に基づいて位相シフトマスクにおける位相シフタの位相量を求める位相量算出手段と、を備えた位相シフトマスク検査装置である。

【0016】このような位相シフトマスク検査装置であれば、ランプから拡散放射される遠紫外光、又はレーザ光源から出力される遠紫外のレーザ光が切り替えられて照明光学系に送られ、この照明光学系により互いに直交する偏光面を持つ2つの直線偏光に分離されて位相シフトマスクに照射される。

【0017】この場合、レーザ光源から出力される遠紫外のレーザ光は、光源変換光学系により等価な強度を持つ拡散放射の光源に変換されて照明光学系に送られる。そして、この位相シフトマスクを透過した2つの直線偏光は、検出光学系により重ね合わせられ、その干渉光に基づいて位相量算出手段により位相シフトマスクの位相シ

フタの位相量が求められる。

【0018】請求項3によれば、請求項1又は2記載の位相シフトマスク検査装置において、照明光学系は、ウォラストンプリズムを用いた。請求項4によれば、請求項1又は2記載の位相シフトマスク検査装置において、中心波長が300nm以下の遠紫外光又はレーザ光を位相シフトマスクに照射する。請求項5によれば、請求項2記載の位相シフトマスク検査装置において、ランプとして水銀ランプを用い、レーザ光源としてエキシマレーザ装置を用いた。

【0019】

【発明の実施の形態】

(1) 以下、本発明の第1の実施の形態について図面を参照して説明する。図1は位相シフトマスク検査装置の構成図である。遠紫外光を放射する光源20は、例えばHg-Xeランプに代表される水銀ランプ、KrFエキシマレーザ装置である。これら光源20は、遠紫外光として中心波長248nmの光をそれぞれ出力するものである。

【0020】この光源20から出力されるランプ光又はエキシマレーザ光の光路上には、照明光学系21が配置されている。この照明光学系21は、この光源20から放射された遠紫外光であるランプ光又はエキシマレーザ光を互いに直交する2つの直線偏光に分離して位相シフトマスク3に照射するものである。

【0021】具体的に照明光学系21は、光源20から出力されるランプ光又はエキシマレーザ光の光路上に、各光学レンズ22~24、偏光子25と、偏光分離プリズムとしての照明側ウォラストンプリズム26、各光学レンズ27、28及びコンデンサレンズ29を配置した構成となっている。

【0022】このうち照明側ウォラストンプリズム26は、ランプ光又はエキシマレーザ光を互いに直交する2つの直線偏光に分離するもので、これら2つの直線偏光を同一光路上でわずかに横ずれした2つの照明として出射する機能を有している。

【0023】一方、位相シフトマスク3の透過光の光路上には、検出光学系30が配置されている。この検出光学系30は、位相シフトマスク3を透過した2つの直線偏光を重ね合わせて干渉光を発生させる機能を有するもので、位相シフトマスク3の透過光の光路上に、対物レンズ31、各光学レンズ32、33、偏光分離プリズムとしての検出側ウォラストンプリズム34、検光子35及び光学レンズ36を配置した構成となっている。

【0024】そして、この光学レンズ36を透過する光の光路上には、ピンホール37を介して位相量算出手段を構成するフォトマル40及び算出部41が設けられている。

【0025】このうちフォトマル40は、入射する干渉光強度に対応した電圧信号を出力するものであり、光学

レンズ36の結像位置に配置されている。又、算出部31はフォトマル40から出力される電圧信号を入力し、干渉光強度に基づいて位相シフトマスク3におけるシフタの位相量を演算し求める機能を有している。

【0026】次に上記の如く構成された装置の作用について説明する。Hg-Xeランプ又はKrFエキシマレーザ装置の光源20から出力された遠紫外光として中心波長3000nm以下のランプ光又はエキシマレーザ光は、各光学レンズ22～24を通して偏光子25に入射し、ここで照明側ウォラストンプリズム26の偏光角と光軸fと垂直な面内で45°回転した方向の直線偏光が取り出される。

【0027】この光が照明側ウォラストンプリズム26に入射すると、この照明側ウォラストンプリズム26からは、互いに直交した2つの直線偏光に分離される。この場合、これら2つの分離角は、照明側ウォラストンプリズム26の張り合わせ面の角度に応じて決まる。

【0028】従って、これら直交する2つの直線偏光は、同一光路上でわずかに横ずれした2つの照明として各光学レンズ27、28及びコンデンサレンズ29を通して位相シフトマスク3に照射される。

【0029】すなわち、これら直交する2つの直線偏光は、その一方の光が位相シフトマスク3のガラス基板1、他方の光が位相シフター2を透過する。この位相シフトマスク3を透過した2つの光は、対物レンズ31、各光学レンズ32、33を通して検出側ウォラストンプリズム34に入射し、ここで重ね合わされる。

【0030】なお、この検出側ウォラストンプリズム34の張り合わせ面は、対物レンズ31の瞳面と一致する

$$\theta = \tan^{-1} \{ (I_s - I_1) / (I_s + I_1) \} \quad \cdots (1)$$

なお、この場合は、4点の場合にて説明したが、さらに多点の場合でももちろんよい。この場合は正弦波状に変化する各電圧信号をフーリエ変換的手法を用いることで演算し、位相シフタでの位相量を求めることができる。以下の説明でも同様である。

【0035】このように上記第1の実施の形態においては、光源20から放射された中心波長3000nm以下のランプ光又はエキシマレーザ光を、照明側ウォラストンプリズム26を備えた照明光学系21により互いに直交する2つの直線偏光に分離して位相シフトマスク3に照射し、この位相シフトマスク3を透過した2つの直線偏光を検出光学系30により重ね合わせ、その干渉光に基づいて算出部41により位相シフトマスク3の位相シフタ2の位相量を求めるようにしたので、照明側ウォラストンプリズム26により分離される2光は、同一光路上でわずかに横ずれした2つの照明として位相シフトマスク3に照射されるものとなり、これら2光がそれぞれ別々に空気の乱れの影響を受けることはなく、同一の空気の流れの条件で位相シフトマスク3に照射できる。

【0036】従って、位相シフタ2の位相量を高精度に

ように配置されている。この検出側ウォラストンプリズム34により重ね合わされた2つの光は、検光子35を通して干渉を起こし、この干渉光が光学レンズ36、ピンホール37を通してフォトマル40に入射する。すなわち、フォトマル40のセンサ面には、位相シフトマスク3の横ずらし干渉画像が投影される。

【0031】このフォトマル40に入射する干渉光は、2つの直交する直線偏光のうち一方が位相シフトマスク3のガラス基板1を透過し、他方が位相シフタ2を透過しているので、位相シフタ2の位相量に応じた干渉強度となっている。

【0032】そして、このフォトマル40は、入射する干渉光強度に対応した電圧信号を出力する。ここで、位相シフトマスク3の位相シフタ2の位相量を測定する場合には、位相シフト干渉法、すなわち照明側ウォラストンプリズム26を光軸fに対して垂直方向(イ)に移動させ、照明側ウォラストンプリズム26により分離される互いに直交する偏光面を持つ直線偏光の2光の位相量を例えば0°、90°、180°、270°にそれぞれ変化する。

【0033】フォトマル40は、これら位相量0°、90°、180°、270°のときの各干渉光の強度I₀～I₄に応じた各電圧信号を出力する。算出部41は、フォトマル40から出力される各干渉光強度I₀～I₄に応じた各電圧信号を入力し、これら電圧信号から次式を演算して位相シフトマスク3における位相シフタ2の位相量θを求める。

【0034】

測定でき、その測定結果の信頼性を向上できる。このように位相シフタ2の位相量を高精度に測定できるので、位相シフトマスク3の設定値と比較することにより位相シフトマスク3の良否を判定でき、さらに位相シフト露光にあっては半導体ウエハに対して高精度にパターン転写ができる、半導体製造における歩留まりを向上できる。

【0037】又、位相シフタ2として半透明の膜を用いたハーフトーン型の集積度の高い位相シフトマスク3は、位相シフタ2の位相量を測定するのには、半導体露光装置の光源と同じ波長の光を用いて測定をしなければならない。しかし、上記装置では半導体露光装置の光源と同一の中心波長248nmのHg-Xeランプ光又はKrFエキシマレーザ光を用いるので、高精度にかつ確実に位相シフタ2の位相量を測定できる。

【0038】なお、上記第1の実施の形態は、次の通り変形してもよい。上記第1の実施の形態では、位相シフトマスク3上に2つの横ずれした照明エリアを形成し、位相シフトマスク3の2つの横ずれした像を重ね合わせた横ずらし干渉画像をフォトマル40のセンサ面に投影しているが、マスク像をフォトマル40のセンサ面に結

像せず、照明側ウォラストンプリズム 26 で分離された 2 光束を照明レンズで位相シフトマスク 3 上のわずかに離れた 2 点に小さく絞り込み、一方を位相シフタ 2 に他方をガラス基板 1 に照射する。そして、位相シフトマスク 3 を透過した 2 光束を再び検出側ウォラストンプリズム 34 で重ね合わせて干渉させ、フォトマル 40 で検出するようにしてよい。

【0039】又、位相シフトマスク 3 のガラス基板 1 と位相シフタ 2 との透過強度を比較することで、位相測定だけでなく透過率の測定もできる。

(2) 次に本発明の第 2 の実施の形態について説明する。なお、図 1 と同一部分には同一符号を付してその詳しい説明は省略する。

【0040】図 2 は位相シフトマスク検査装置の構成図である。中心波長 248 nm の遠紫外光を放射する Hg-Xe ランプ 50 が設けられ、この Hg-Xe ランプ 50 から出力されるランプ光の光路上に照明光学系 21 が配置されている。

【0041】一方、中心波長 248 nm のエキシマレーザ光を出力する KrF エキシマレーザ装置 51 が設けられている。この KrF エキシマレーザ装置 51 から出力されるエキシマレーザ光の光路上には、拡散板 52、各光学レンズ 53、54 及びハーフミラー 55 が配置されている。

【0042】このうち拡散板 52 は、KrF エキシマレーザ装置 51 から出力されたエキシマレーザ光を等価的に拡散放射の光源に変換する光源変換光学系としての機能を有している。

【0043】又、ハーフミラー 55 は、KrF エキシマレーザ装置 51 から出力されたエキシマレーザ光を、照明光学系 21 の光軸 f 方向、すなわち光学レンズ 24 から偏光子 25、照明側ウォラストンプリズム 26、各光学レンズ 27、28 及びコンデンサレンズ 29 を通して位相シフトマスク 3 に照射するものとなっている。

【0044】従って、Hg-Xe ランプ 50 又は KrF エキシマレーザ装置 51 を 2 種の露光装置に応じて切り替えて使用できる構成となっている。次に上記の如く構成された装置の作用について説明する。

【0045】先ず、Hg-Xe ランプ 50 から出力されたランプ光は、各光学レンズ 22～24 を通して偏光子 25 に入射し、ここで照明側ウォラストンプリズム 26 の偏光角と光軸 f と垂直な面内で 45° 回転した方向の直線偏光が取り出される。

【0046】この光が照明側ウォラストンプリズム 26 に入射すると、この照明側ウォラストンプリズム 26 からは、互いに直交した偏光面を持つ 2 つの直線偏光に分離され、これら 2 光は、わずかに横ずれした 2 つの照明として各光学レンズ 27、28 及びコンデンサレンズ 29 を通して位相シフトマスク 3 に照射される。

【0047】この位相シフトマスク 3 を透過した 2 つの

光は、対物レンズ 31、各光学レンズ 32、33 を通して検出側ウォラストンプリズム 34 に入射し、ここで重ね合わされる。

【0048】この検出側ウォラストンプリズム 34 により重ね合わされた 2 つの光は、検光子 35 を通すことにより干渉を起こし、この干渉光が光学レンズ 36、ピンホール 37 を通してフォトマル 40 に入射する。

【0049】このフォトマル 40 に入射する干渉光は、2 つの直交する直線偏光のうち一方が位相シフトマスク 3 のガラス基板 1 を透過し、他方が位相シフタ 2 を透過しているので、位相シフタ 2 の位相量に応じた干渉強度となっている。

【0050】ここで、位相シフトマスク 3 の位相シフタ 2 の位相量を測定する場合、照明側ウォラストンプリズム 26 を光軸 f に対して垂直方向 (イ) に移動させ、互いに直交する直線偏光の 2 光の位相量を例えば 0°、90°、180°、270° にそれぞれ変化する。

【0051】フォトマル 40 は、これら位相量 0°、90°、180°、270° のときの各干渉光の強度 $I_1 \sim I_4$ に応じた各電圧信号を出力する。算出部 41 は、フォトマル 40 から出力される各干渉光強度 $I_1 \sim I_4$ に応じた各電圧信号を入力し、これら電圧信号から上記式(1) を演算して位相シフトマスク 3 における位相シフタ 2 の位相量 θ を求める。

【0052】一方、KrF エキシマレーザ装置 51 から出力されたエキシマレーザ光は、拡散板 52 により等価的に拡散放射の光源に変換され、各光学レンズ 53 からハーフミラー 55 を通して照明光学系 21 の光軸 f に入射し、さらに偏光子 25、照明側ウォラストンプリズム 26、各光学レンズ 27、28 及びコンデンサレンズ 29 を通して位相シフトマスク 3 に照射される。

【0053】この位相シフトマスク 3 を透過した 2 つの光は、対物レンズ 31、各光学レンズ 32、33 を通して検出側ウォラストンプリズム 34 に入射し、ここで重ね合わされる。

【0054】この重ね合わされた 2 つの光は、検光子 35 を通すことにより干渉を起こし、この干渉光が光学レンズ 36、ピンホール 37 を通してフォトマル 40 に入射する。

【0055】このフォトマル 40 に入射する干渉光は、2 つの直交する直線偏光のうち一方が位相シフトマスク 3 のガラス基板 1 を透過し、他方が位相シフタ 2 を透過しているので、位相シフタ 2 の位相量に応じた干渉強度となっている。

【0056】ここで、位相シフトマスク 3 の位相シフタ 2 の位相量を測定する場合、照明側ウォラストンプリズム 26 を光軸 f に対して垂直方向 (イ) に移動させ、互いに直交する直線偏光の 2 光の位相量を例えば 0°、90°、180°、270° にそれぞれ変化する。

【0057】フォトマル 40 は、これら位相量 0°、90°

0°、180°、270°のときの各干渉光の強度 $I_0 \sim I_4$ に応じた各電圧信号を出力する。算出部 41 は、フォトマル 40 から出力される各干渉光強度 $I_0 \sim I_4$ に応じた各電圧信号を入力し、これら電圧信号から上記式(1)を演算して位相シフトマスク 3 における位相シフタの位相量 θ を求める。

【0058】このように上記第2の実施の形態においては、Hg-Xeランプ 50 又はKrFエキシマレーザ装置 51 を切り替える構成としたので、上記第1の実施の形態と同一の効果を奏することは言うまでもなく、KrFエキシマレーザ装置 51 をランプ光と等価な拡散光源として用いることができ、これによりHg-Xeランプ 50 とKrFエキシマレーザ装置 51 とを2種の露光装置に応じて切り替えて使用することができ、これら露光装置と同一の光源を用いて位相シフトマスク 3 における位相シフタの位相量 θ を求めることができる。

【0059】なお、上記第2の実施の形態は、次の通り変形してもよい。例えば、光源としては、ArFレーザ(波長 193 nm)を用いてもよい。要は 256 Mbit DRAM 等の高集積度の半導体に対する露光装置に用いられる遠紫外光を発する光源であればよい。

【0060】

【発明の効果】以上詳記したように本発明の請求項1～5によれば、位相シフタの位相量を高精度に測定できる

信頼性を向上させた位相シフトマスク検査装置を提供できる。又、本発明の請求項2～5によれば、各種の露光装置と同一光源を用いて位相シフトマスクにおける位相シフタの位相量を求めることができる位相シフトマスク検査装置を提供できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明に係る位相シフトマスク検査装置の第1の実施の形態を示す構成図。

【図2】本発明に係る位相シフトマスク検査装置の第2の実施の形態を示す構成図。

【図3】位相シフトマスクの構成図。

【図4】従来の位相シフタの膜厚測定装置の構成図。

【符号の説明】

3…位相シフトマスク、

20…光源、

21…照明光学系、

26, 34…ウォラストンプリズム、

30…検出光学系、

40…フォトマル、

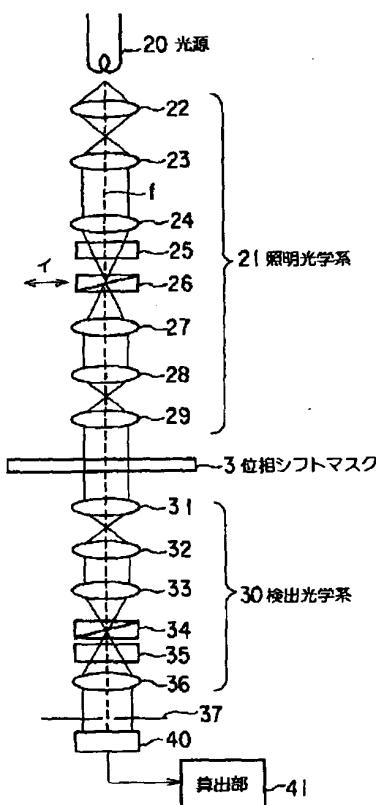
41…算出部、

50…Hg-Xeランプ、

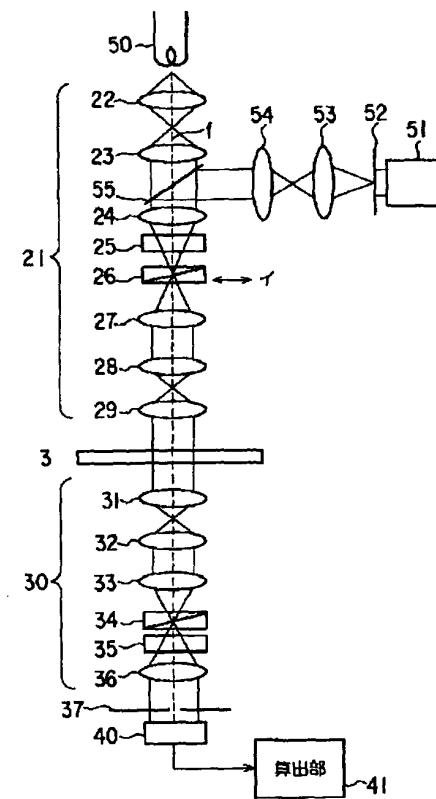
51…KrFエキシマレーザ装置、

55…ハーフミラー。

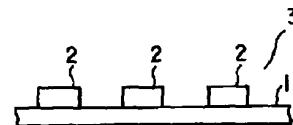
【図1】



【図2】



【図3】



【図4】

